

Владимир Иванович Иванов-Омский



15 апреля 2022 года на 90-м году жизни скончался Владимир Иванович Иванов-Омский, выдающийся ученый и организатор науки, прекрасный человек, наш коллега, учитель и друг.

Владимир Иванович родился 19 декабря 1932 г. в Волгограде. В 1955 г. он с отличием окончил химический факультет Ленинградского государственного университета по специальности „физическая химия“. По окончании ЛГУ Владимир Иванович был направлен в аспирантуру Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе АН СССР, где под руководством своих учителей Б.Т. Коломийца и Н.А. Горюновой приступил к исследованию полупроводниковых материалов. С тех пор вся его жизнь была неразрывно связана с ФТИ, где он вначале руководил сектором электронных явлений в полуметаллах, а затем, долгие годы, лабораторией фотоэлектрических явлений в полупроводниках.

В научных кругах Владимир Иванович известен прежде всего своими работами в области физики узкощелевых и бесщелевых полупроводников и отрицательной люминесценции. Широкое признание получили и результаты проводившихся им в последние годы исследований структуры нанокompозитов на основе аморфного углерода и особенностей электронных и оптических явлений в них, а также физики воды и различных биообъектов, включая древесину и ткани человека. За цикл работ по обнаружению и исследованию отрицательной

люминесценции Владимир Иванович был удостоен премии им. Я.И. Френкеля, а за открытие и исследование свойств бесщелевых и узкощелевых полупроводников он стал лауреатом Государственной премии СССР. В своей деятельности В.И. Иванов-Омский уделял время не только фундаментальным исследованиям; много времени и сил он отдавал и прикладным работам, — под его руководством разрабатывалась отечественная технология инфракрасных фотоприемников на основе твердых растворов теллуридов кадмия-ртути. Владимир Иванович — заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, доктор физико-математических наук, профессор. Долгие годы и до последних дней своей жизни он был членом редколлегии журнала „Физика и техника полупроводников“. На протяжении ряда лет он был редактором журнала *Semiconductor Science and Technology*, организовал региональное отделение редакции этого журнала в ФТИ.

Много внимания В.И. Иванов-Омский уделял подготовке молодых специалистов, более 25 лет он читал курс общей физики студентам материаловедческих специальностей Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Им были разработаны курсы лекций по общей физике и физике твердого тела для технических факультетов университета и по физике воды для гидротехнического факультета. В течение нескольких десятилетий и до самой своей

кончины Владимир Иванович был бессменным членом Диссертационных советов ФТИ по специальности „физика полупроводников“.

В общей сложности В.И. Ивановым-Омским было опубликовано около 400 научных статей. Под его научным руководством защищено 44 кандидатских диссертации, среди его учеников 14 докторов наук. Владимир Иванович работал в ведущих научных учреждениях Франции, Польши, Великобритании, Германии, а также в Японии и Канаде и везде пользовался большим

уважением коллег; до последних дней он работал над совместным проектом с Университетом западного Онтарио в Канаде. В.И. Иванов-Омский был действительным членом Европейской академии наук и искусств в Зальцбурге, почетным доктором (Doctor honoris causa) Тираспольского государственного университета (Республика Молдова) и Дрогобычского педагогического института им. И.Я. Франко (Украина).

Светлая память о В.И. Иванове-Омском навсегда сохранится в сердцах его коллег, учеников и друзей.

Друзья, коллеги, ученики

Редколлегия журнала „Физика и техника полупроводников“